

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 05-291621
 (43)Date of publication of application : 05.11.1993

(51)Int.CI. H01L 33/00

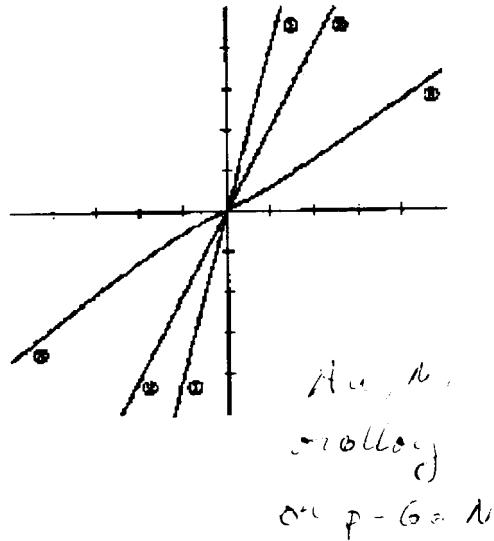
(21)Application number : 04-118227 (71)Applicant : NICHIA CHEM IND LTD
 (22)Date of filing : 10.04.1992 (72)Inventor : SENOO MASAYUKI
 NAKAMURA SHUJI

(54) ELECTRODE MATERIAL OF GALLIUM NITRIDE COMPOUND SEMICONDUCTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To materialize a light emitting device, wherein driving voltage is lowered and brightness is raised, making use of a gallium nitride compound semiconductor, by getting the ohmic contact from a p-type layer and an n-type layer.

CONSTITUTION: At least one kind of metal being selected from the group consisting of Au, Pt, Ag, and Ni or their alloy is used for $\text{GaXAl}_{1-X}\text{N}$ (but, $0 \cdot X \cdot 1$) doped with p-type impurities, and at least one kind of metal being selected from the group consisting of Al, Cr, Ti, and In or their alloy is used for $\text{GaXAl}_{1-X}\text{N}$ doped with n-type impurities.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 13.12.1995

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 2778349

[Date of registration] 08.05.1998

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-291621

(43)公開日 平成5年(1993)11月5日

(51)Int.Cl.⁵
H 01 L 33/00

識別記号 庁内整理番号
E 8934-4M
C 8934-4M

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数2(全3頁)

(21)出願番号 特願平4-118227

(22)出願日 平成4年(1992)4月10日

(71)出願人 000226057

日亜化学工業株式会社

徳島県阿南市上中町岡491番地100

(72)発明者 妹尾 雅之

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化
学工業株式会社内

(72)発明者 中村 優二

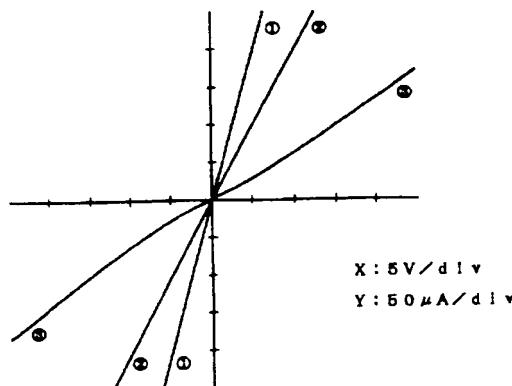
徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化
学工業株式会社内

(54)【発明の名称】窒化ガリウム系化合物半導体の電極材料

(57)【要約】

【目的】p型層およびn型層からオーム接觸を得ることにより、窒化ガリウム系化合物半導体を利用して、低駆動電圧化、高輝度化した発光デバイスを実現する。

【構成】p型不純物をドープした $Ga_xAl_{1-x}N$ にAu、Pt、Ag、Niよりなる群から選択される少なくとも一種の金属、またはそれらの合金を使用し、またn型不純物をドープした $Ga_xAl_{1-x}N$ にはAl、Cr、Ti、Inよりなる群から選択される少なくとも一種の金属、またはそれらの合金を使用する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 p型不純物をドープした一般式 G_aX_A
 $_{1-X}N$ （但し $0 \leq X \leq 1$ ）で表される窒化ガリウム系化合物半導体とオーミック接触を得る電極材料として、Au、Pt、Ag、Niよりなる群から選択される少なくとも一種の金属、またはそれらの合金を使用することを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体の電極材料。

【請求項2】 n型不純物をドープした一般式 $G_aX_A_{1-X}$ N（但し $0 \leq X \leq 1$ ）で表される窒化ガリウム系化合物半導体とオーミック接触を得る電極材料として、Al、Cr、Ti、Inよりなる群から選択される少なくとも一種の金属、またはそれらの合金を使用することを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体の電極材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は紫外、青色発光ダイオード、レーザーダイオード等に使用される窒化ガリウム系化合物半導体の電極材料に係り、特にオーム接觸を得ることのできる電極材料に関するものである。

(0002)

【従来の技術】紫外、青色発光ダイオード、レーザーダイオード等の発光デバイスの材料として、一般式が G_aXAl_1-XN ($0 \leq X \leq 1$) で表される窒化ガリウム系化合物半導体が知られている。しかし、窒化ガリウム系化合物半導体の物性については、未だよく解明されておらず、窒化ガリウム系化合物半導体の p 型層、および n 型層とオーム接触を得ることのできる電極材料もよく知られていないのが実状である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】そのため、窒化ガリウム系化合物半導体を利用して、低駆動電圧化、高輝度化した発光デバイスと実現するには、p型層およびn型層からオームニック接触を得ることが不可欠である。

【0004】本発明はこのような事情を鑑み成されたもので、窒化ガリウム系化合物半導体のp型層およびn型層からオーミック接触の得られる電極材料を提供して、高輝度化、低電圧駆動化できる発光デバイスを実現するものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らはMOCVD法を用い、サファイア基板上にSiをドープしたn型GaxAl_{1-x}Nと、Mgをドープしたp型GaxAl_{1-x}Nとをそれぞれ成長させ、さらにp型GaxAl_{1-x}Nには電子線を照射、または500°C以上にアニーリングしてさらに低抵抗なp型とした後、n型及びp型GaxAl_{1-x}Nに数十種類の電極材料を蒸着して、オーム接觸の確認を取ったところ、特定の金属、またはそれらの合金に対してのみ良好なオーム接觸が得られることを発見し、本発明を成すに至った。

【0006】即ち、本発明の窒化ガリウム系化合物半導

体の電極材料は、p型不純物をドープした窒化ガリウム系化合物半導体にはAu、Pt、Ag、Niよりなる群から選択される少なくとも一種の金属、またはそれらの合金を使用することを特徴とするものであり、また、n型不純物をドープした窒化ガリウム系化合物半導体には、Al、Cr、Ti、Inよりなる群から選択される少なくとも一種の金属、またはそれらの合金を使用することを特徴とするものである。

[0007]

【実施例】図1にp型GaxAl_{1-x}Nに電極を蒸着し、その電流電圧特性を測定してオーム接觸を調べた結果を示す。①はPt電極単独、②はNiをベースとし、その上にAuを設けた電極、③はAu電極単独である。また、いうまでもなくNi電極単独またはNiをベースとしその上にPt、Agを設けた場合は②と同一の直線となる。

【0008】この図に示すようにいずれの電極材料でも
p型層に対しオーム接触が得られるが、特に好まし
い電極材料として①P_t、②N_iベースの電極を挙げる。

20 ことができる。特にNiをベースとすることにより、例えば、p型GaAsAl_{1-X}Nに対しアニーリング等の熱処理を行った場合、Au電極単独であれば剥がれ落ちてしまう欠点があるが、アニーリングの熱にも耐えることができ、強固に電極を付着させることができる。蒸着する好ましいNiの厚さは0.01μm～0.5μmであり、その上に形成するAuの厚さは0.01μm～0.8μmである。それらの範囲で電極を形成することにより、剥がれ落ちにくく、良好なオーミック接触が得られる。

30 [0009] 図2にn型GaxAl_{1-x}Nに同じく電極を蒸着し、その電流電圧特性を測定してオーミック接触を調べた結果を示す。④はCrをベースとし、その上にAl₁を設けた電極、⑤はAl₁電極単独、⑥はTi電極単独である。Cr電極単独またはCrをベースとしその上にTi、Inを設けた場合は②と同一の直線となる。

【0010】この図に示すようにいずれの電極材料でもn型層に対しオーム接觸が得られるが、特に好ましい電極材料として④Crベースの電極、⑤Al電極を挙げることができる。

40 【0011】窒化ガリウム系化合物半導体に不純物をドープしてp型にし得る不純物としては例えはMg、Zn、Cd、Be、Ca等を用いることができ、またn型にし得る不純物としてはSi、Sn、Ge等を用いることができる。

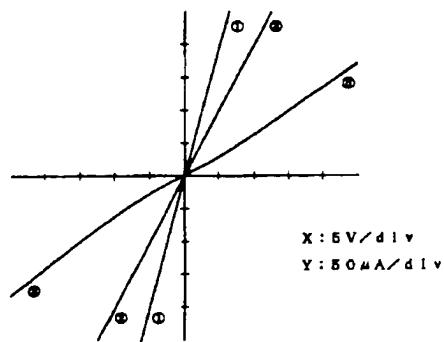
[0012]

【発明の効果】以上説明したように本発明の電極材料によると、好ましくp型及びn型 $Ga_xAl_{1-x}N$ とオーム接触が得られるため、 $Ga_xAl_{1-x}N$ を利用した発光ダイオード、レーザーダイオード等の開発に向けてその利用価値は多大である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 電極を蒸着したp型 $Ga_xAl_{1-x}N$ の電流電圧特性を示す図。

【図1】



【図2】 電極を蒸着したn型 $Ga_xAl_{1-x}N$ の電流電圧特性を示す図。

【図2】

